

教科目名 電子工学 (Electronics)

学科名・学年 : 電気電子工学科 4年

単位数など : 必履修 2単位 (前期1コマ, 後期1コマ, 学習保証時間 45時間)

担当教員 : 高橋徹

授業の概要			
電子デバイスを理解する上での基礎概念を学び、動作原理を知りその応用素子について学習する。pn接合ダイオードについて、動作機構を定量的に理解する。種々のトランジスタ、半導体応用素子について学習する。バンド理論を通じた理解に重点を置く。			
達成目標と評価方法		大分高専目標(B2), JABEE目標(d1③)	
(1) 電子デバイスの電気的性質や動作を理解する上で重要なエネルギーバンド理論、拡散電流、ドリフト電流について理解し説明することができる。(定期試験)			
(2) バンド理論を用いて、pn接合ダイオード、pn接合トランジスタ、J-FET、MOS-FET、ショットキーダイオード、太陽電池、フォトダイオード、LEDなどの基本的電子デバイスの動作機構を説明できる。(定期試験)			
回	授 業 項 目	内 容	理解度の自己点検
1 7	第1章 エネルギーバンドと電気伝導 1.1 電子の性質と物理現象 1.2 水素原子模型 1.3 バンド理論 1.4 電気伝導	第1章 原子に束縛された電子のエネルギーレベルについて学び、固体結晶の電気的性質をエネルギーバンド構造によって説明する。不純物半導体について学び、p型、n型、キャリア、フェルミレベルについて理解する。半導体中において主たる電気伝導を担うドリフト電流、拡散電流について学ぶ。	【理解の度合い】
8	前期中間試験		【試験の点数】 点
9	前期中間試験の解答と解説		【理解の度合い】
10 14	第2章 pn接合ダイオード 2.1 pn接合 2.2 ダイオード特性 2.3 降伏 2.4 容量	第2章 pn接合におけるバンド構造を分析し、電流電圧特性がダイオード特性となる機構を学ぶ。接合の降伏、トンネル効果、空乏層容量などの重要な性質について学ぶ。	
15	前期期末試験 前期期末試験の解答と解説		【試験の点数】 点
16 18	第3章 接合型バイポーラトランジスタ 3.1 構造と動作機構 3.2 接地と特性	第3章 エレクトロニクスの中心的役割を担うトランジスタのなかで、まず接合型トランジスタについて動作機構とその特性を学ぶ。	【理解の度合い】
19	第4章 金属半導体接触	第4章 金属と半導体の接触によるショットキーダイオード及びオーミックコンタクトについて学ぶ。	
20 22	第5章 電界効果トランジスタ(FET) 5.1 接合形FET 5.2 MIS-FET (MOS-FET)	第5章 電界効果トランジスタについて学ぶ。まず接合型の電界効果トランジスタ(J-FET)について学び、次にMIS-FETのうち、特にMOS-FETについて動作機構およびその特性について分析する。	
23	後期中間試験		【試験の点数】 点
24	後期中間試験の解答と解説		【理解の度合い】
25	第6章 集積回路	第6章 エレクトロニクスを支える技術の一つである集積回路技術について学ぶ。	
26 29	第7章 半導体応用素子(受光素子、発光素子、レーザー等)	第7章 種々の電子デバイスについて、その動作機構を学ぶ。半導体素子についてはバンド理論によるモデルを用いて統一的に議論し、電子デバイスの動作を理解する上での共通の指針を与える。	
30	後期期末試験 後期期末試験の解答と解説		【試験の点数】 点
履修上の注意			【総合達成度】
教科書	古川静二郎, 荻田陽一郎, 浅野重正, 「電子デバイス工学」, 森北出版		
参考図書	S. M. ジー, 「半導体デバイス」, 産業図書		
関連科目	電磁気学 I, II, 電気回路 I, II, 電子回路を基礎とし、5年次の電気材料, 専攻科のセンサ工学, 電子材料工学に発展する		
総合評価	達成目標の(1)~(2)について定期試験で評価する。 総合成績=定期試験の平均 総合評価が60点以上を合格とする。		【総合評価】 点